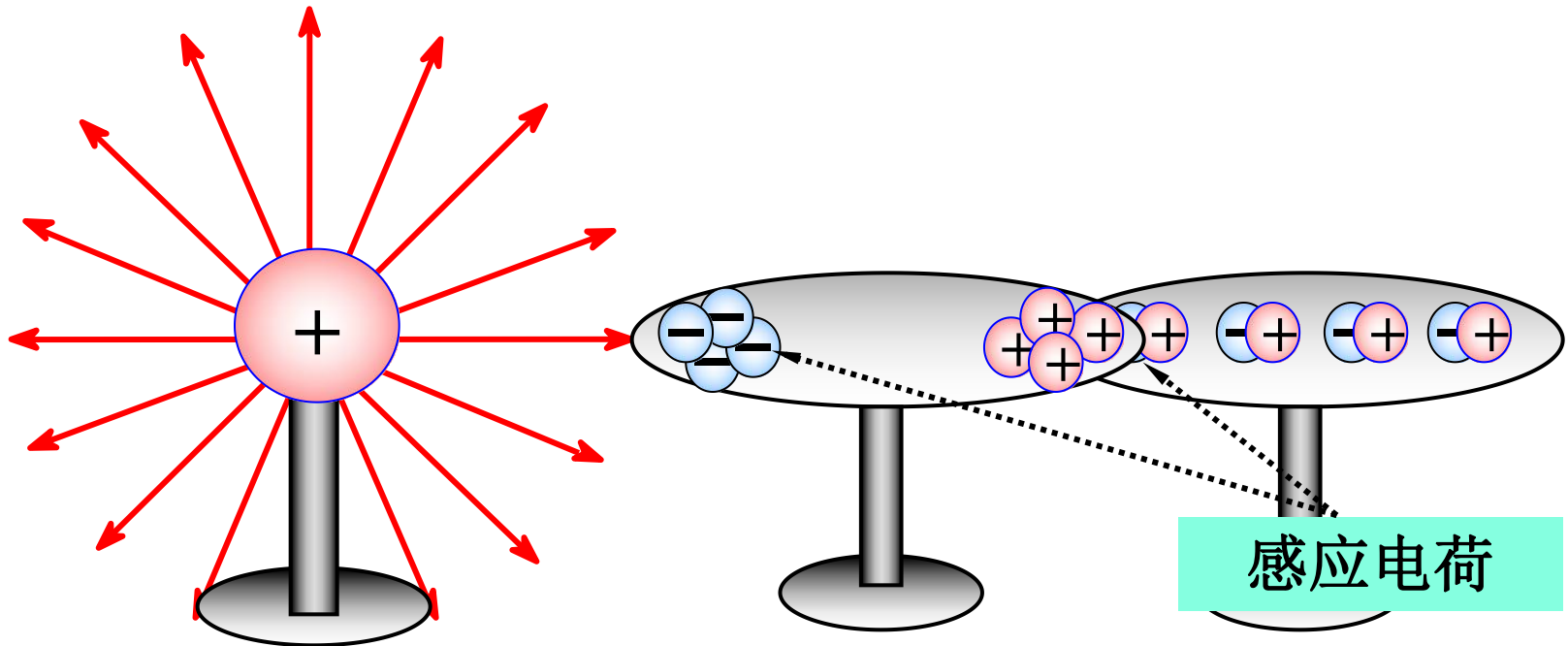


§ 6 静电场中的导体 电容

一、静电感应 静电平衡条件

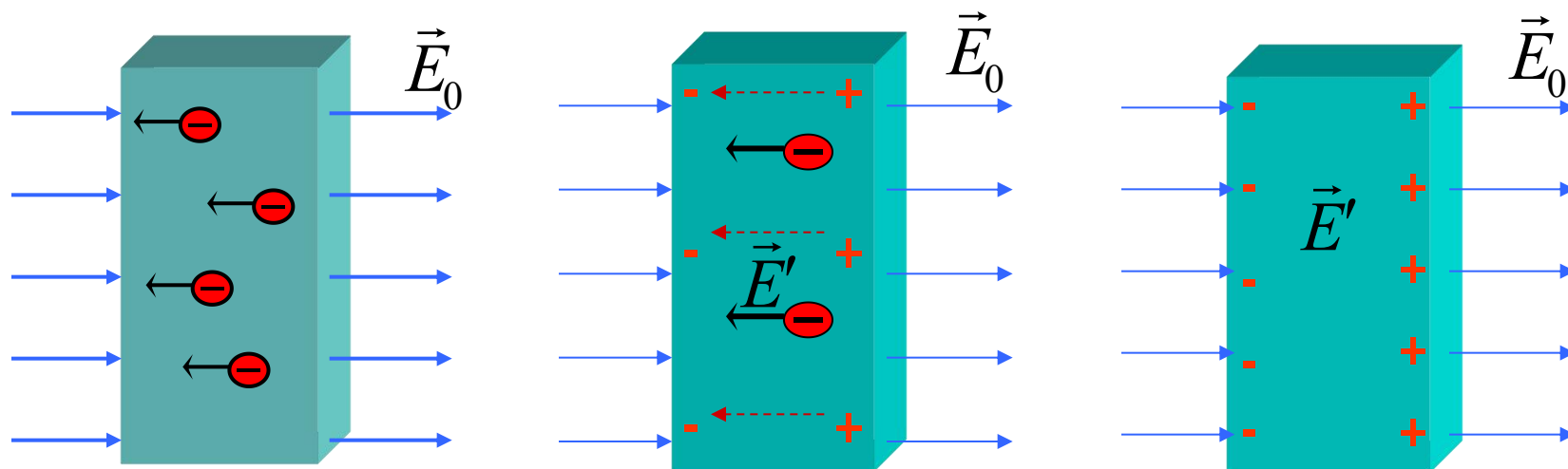
1. 静电感应



2. 静电平衡

导体的特点：有可以移动的自由电子。

导体在电场中，自由电子就要受到电场力而运动，这就改变了导体上原来的电荷分布。



$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \quad \vec{F} = q\vec{E} = -e\vec{E} \quad \vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$$

静电感应

静电平衡

导体的静电平衡状态：导体的内部和表面都没有电荷作任何宏观定向运动的状态。

静电平衡条件

- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零；
- (2) 导体表面处的电场强度的方向，都与导体表面垂直。

推论：

——导体是等势体

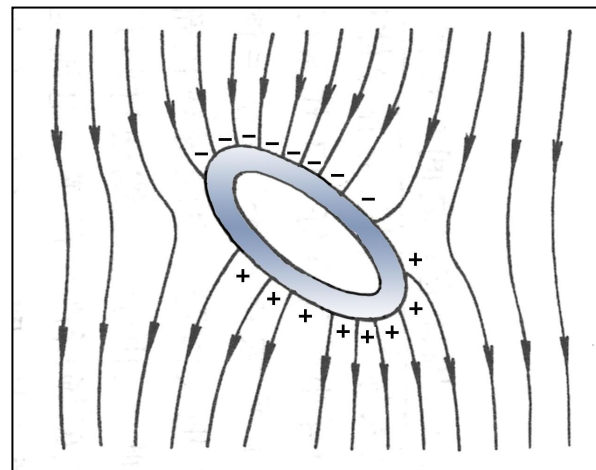
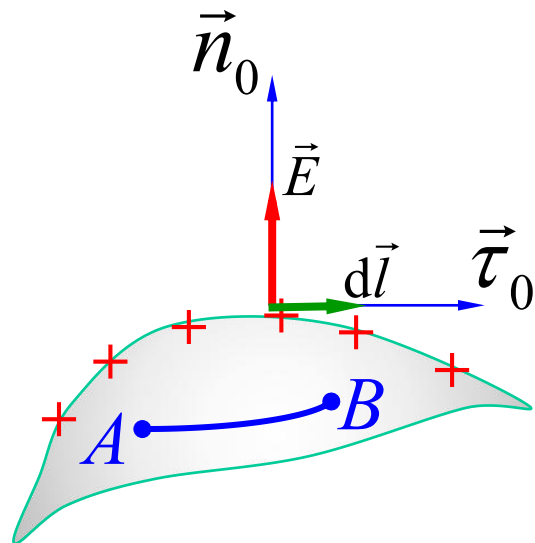
➤ 导体表面是等势面

$$\because \vec{E} \perp d\vec{l}$$

$$\therefore dU = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

➤ 导体内各处电势相等

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

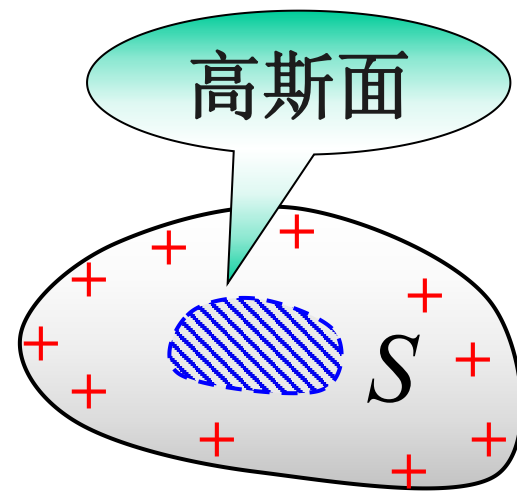


二、静电平衡时导体上电荷的分布

1. 实心导体

$$\because \vec{E} = 0 \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$
$$\therefore \sum_i q_i = 0$$

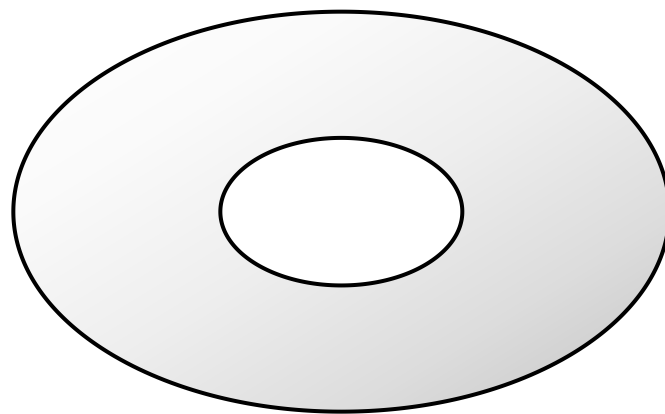
结论：导体内部无电荷



2. 空腔导体

✚ 空腔内无电荷

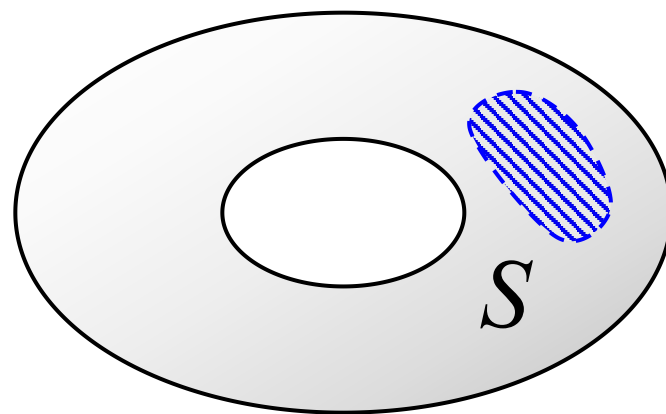
电荷只能分布在空腔的外表面上（内表面无电荷）



➤ 对于空腔导体内取高斯面，有

$$\because \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \therefore \sum q_i = 0$$

——电荷只能分布在表面上

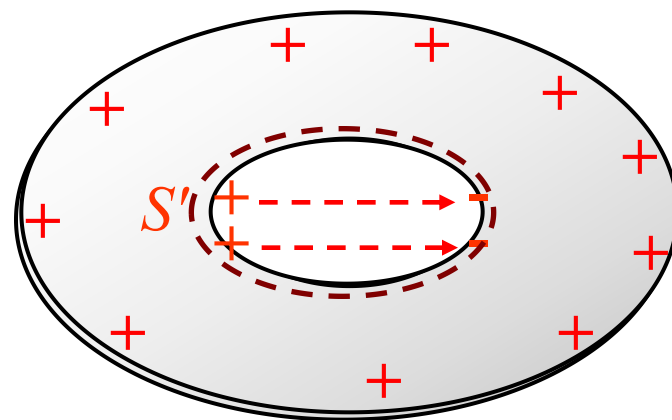


➤ 对于空腔的内表面，有

$$\because \oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \therefore \sum q_i = 0$$

➤ 若内表面带等量异号的电荷，则

$$U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$



——与“静电平衡状态的导体是等势体”相矛盾，故空腔的内表面不带电。

结论：空腔内无电荷时，内表面无电荷，电荷分布在外表面，且腔内无电场线

✚ 空腔内有电荷

$$\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

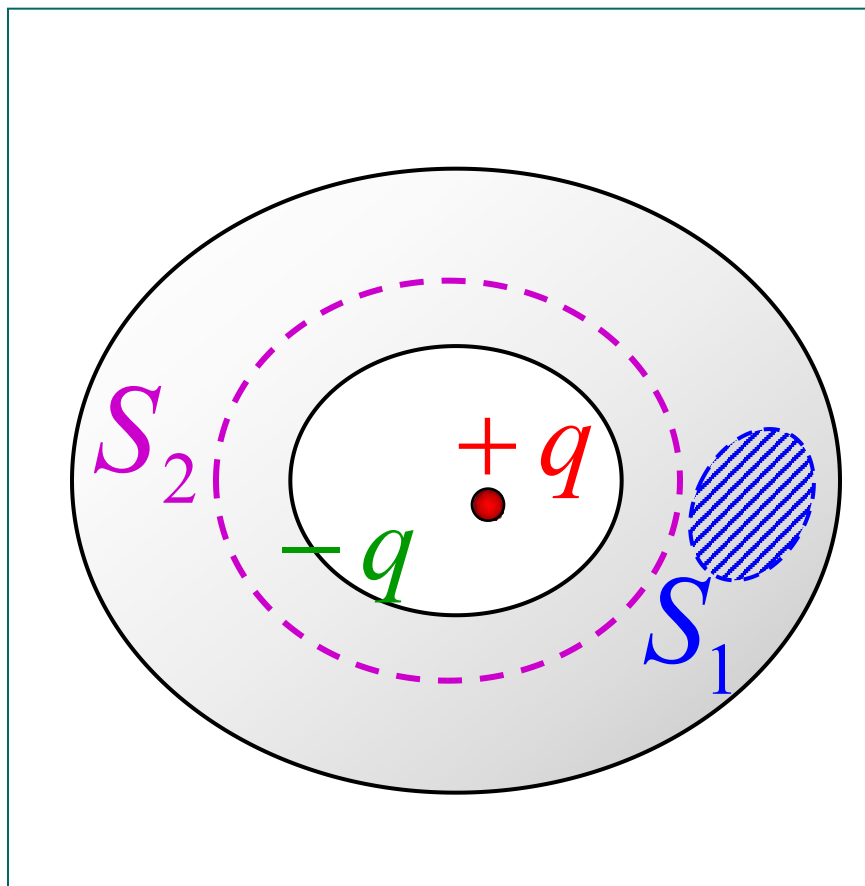
$$\therefore \sum q_i = 0$$

——电荷只能分布在表面上。

内表面上有电荷吗？

$$\therefore \sum q_i = q_{\text{内}} + q = 0$$

$$\therefore q_{\text{内}} = -q$$



结论：当空腔内有电荷 $+q$ 时，内表面因静电感应出现等量异号的电荷 $-q$ ，外表面同时出现等量同号的感应电荷 $+q$ 。

3. 导体表面电场强度与电荷面密度的关系

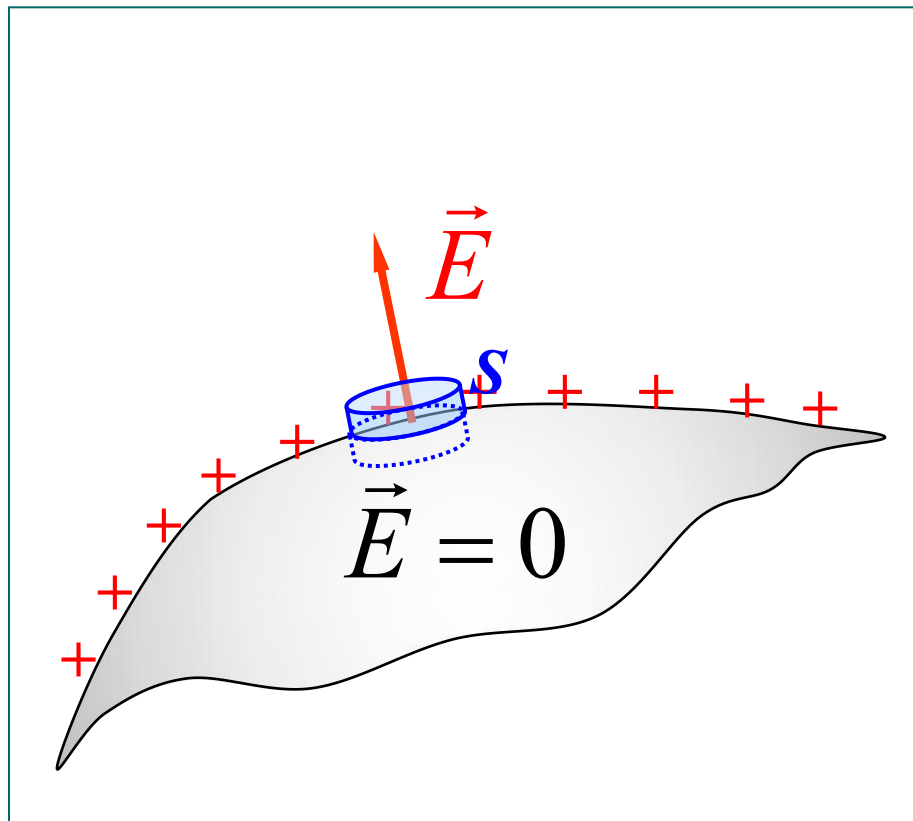
作圆柱形高斯面 S ，使其一个底在导体内。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma S_{\text{底}}}{\epsilon_0}$$

σ 为表面电荷面密度

$$E S_{\text{底}} = \frac{\sigma S_{\text{底}}}{\epsilon_0}$$

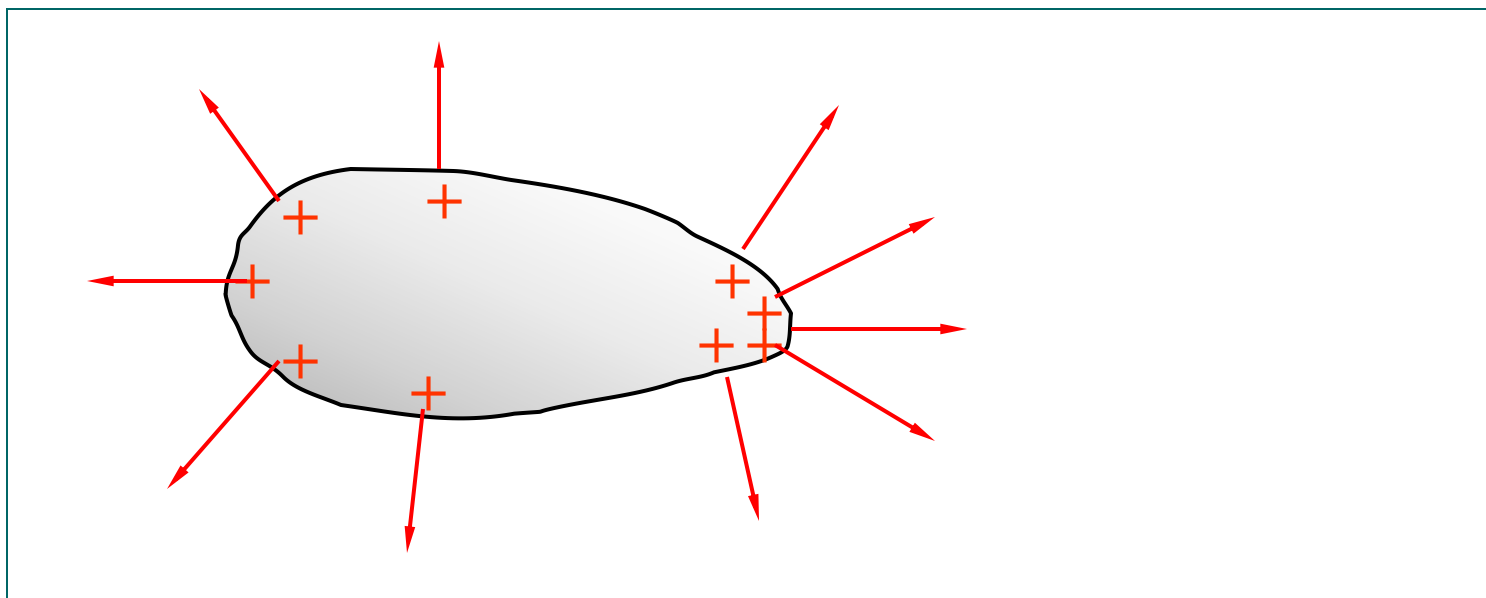
$$\therefore E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



结论：导体表面附近某处的电场强度大小与该处表面电荷面密度成正比。

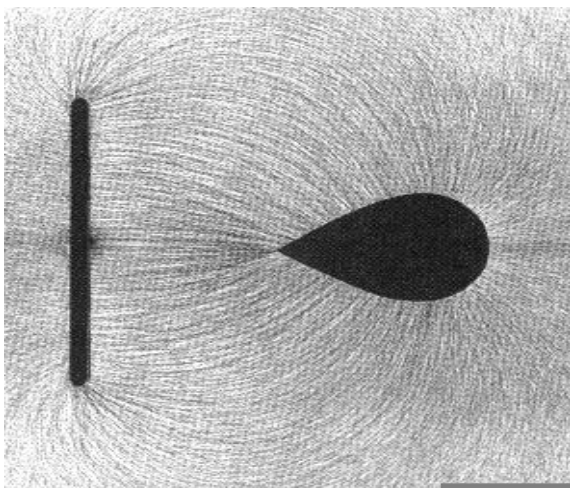
4. 导体表面电荷密度与导体表面曲率的关系

$$\sigma \sim \frac{1}{\boxed{\rho}} \quad \text{曲率半径}$$

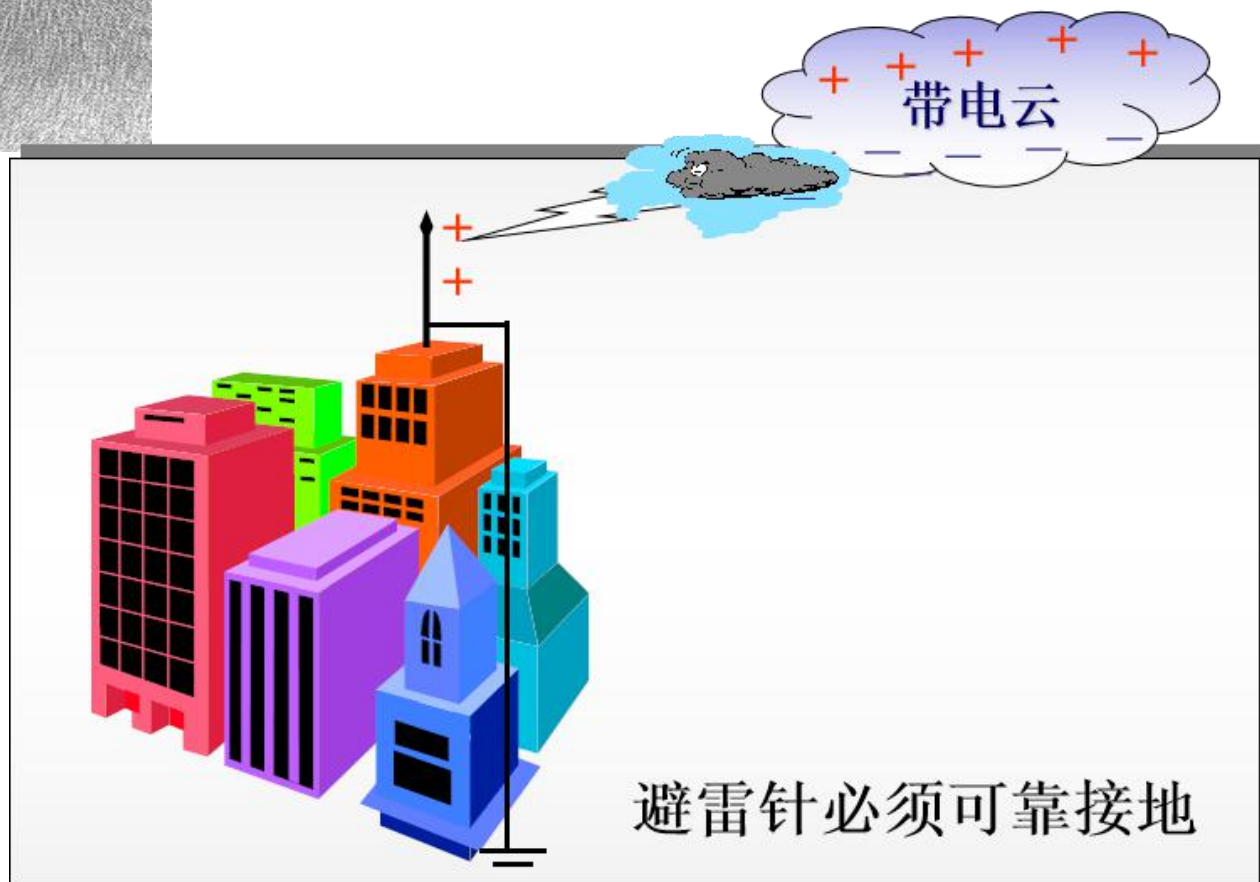


✚ 导体表面电荷分布密度与导体表面的曲率半径成反比。

尖端放电现象

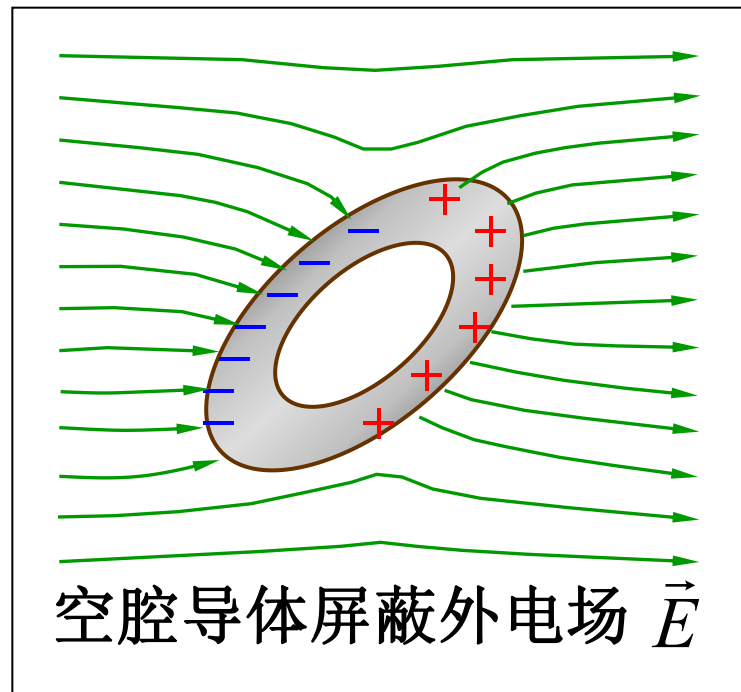
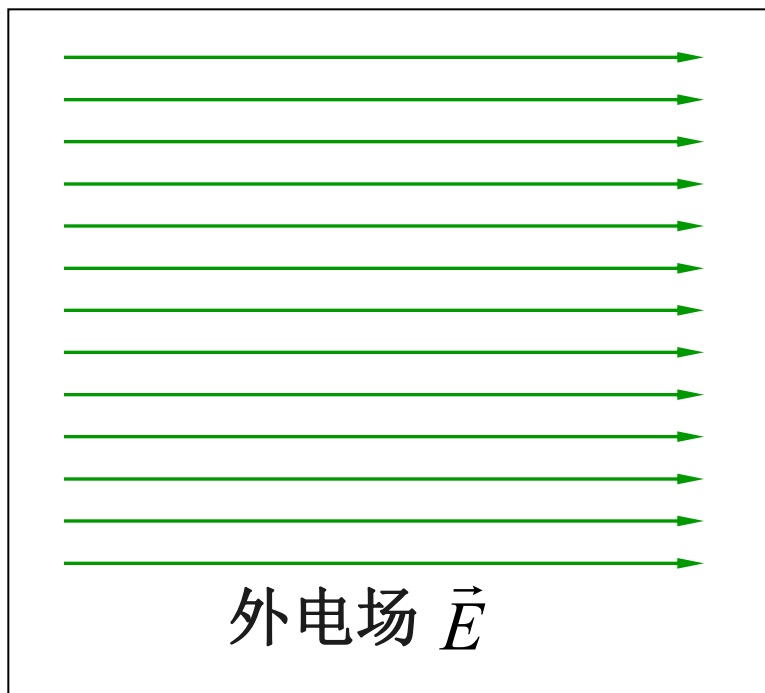


带电导体尖端附近的电场特别大，可使尖端附近的空气发生电离而成为导体产生放电现象。



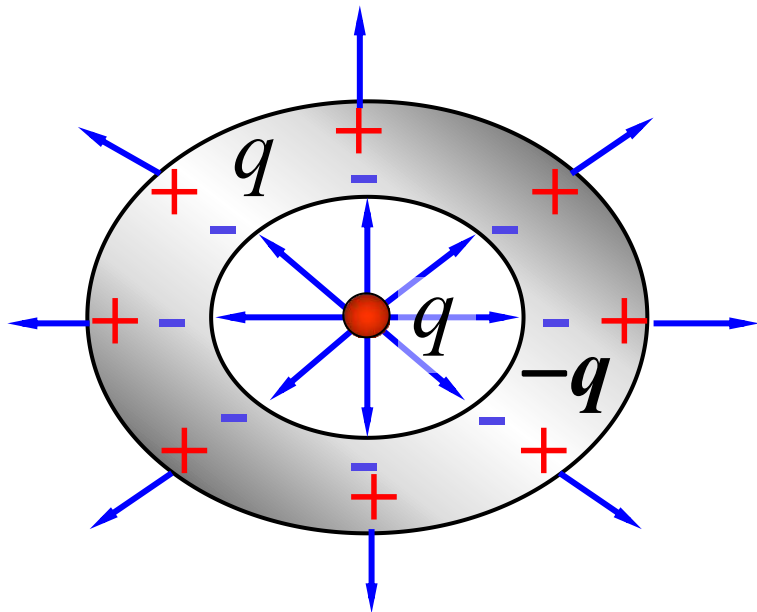
5. 静电屏蔽

(1) 屏蔽外电场

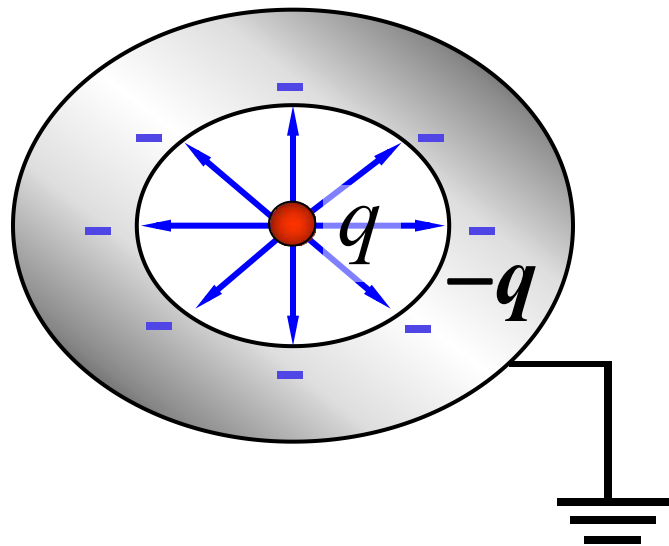


结论：空腔导体可以屏蔽外电场，使空腔内物体不受外电场影响。此时，整个空腔导体和腔内的电势处处相等。

(2) 屏蔽腔内电场



接地空腔导体屏蔽内电场



结论：接地空腔导体将使外部空间不受空腔内的电场影响。

综合以上两种情形可知：一个接地的封闭导体壳，可以起到壳内外互不影响的屏蔽作用。

三、孤立导体的电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

单位：法拉（F）

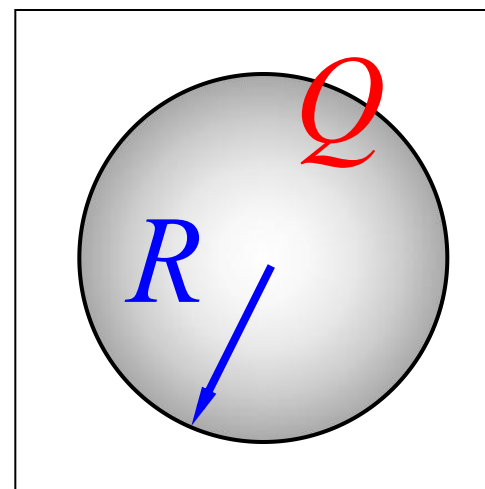
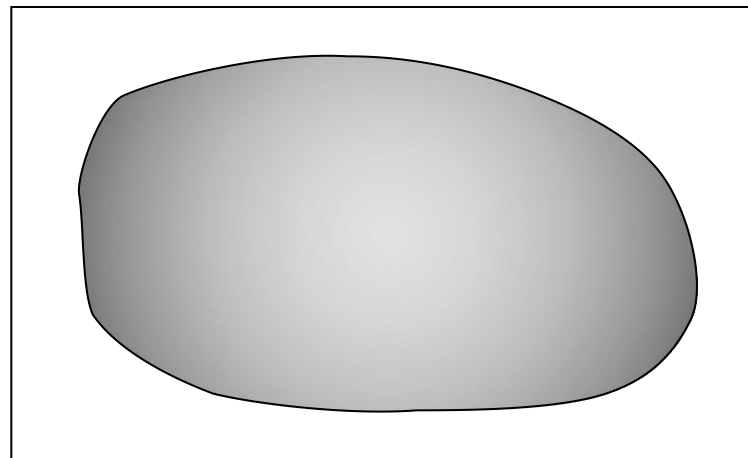
$$1\text{ F} = 1\text{ C/V} \quad 1\text{ F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{ pF}$$

例如：孤立的导体球的电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}} = 4\pi\epsilon_0 R$$

✚ 若是地球大小， $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ，则

$$C \approx 7 \times 10^{-4} \text{ F} \quad \text{——很小!}$$



四、电容器

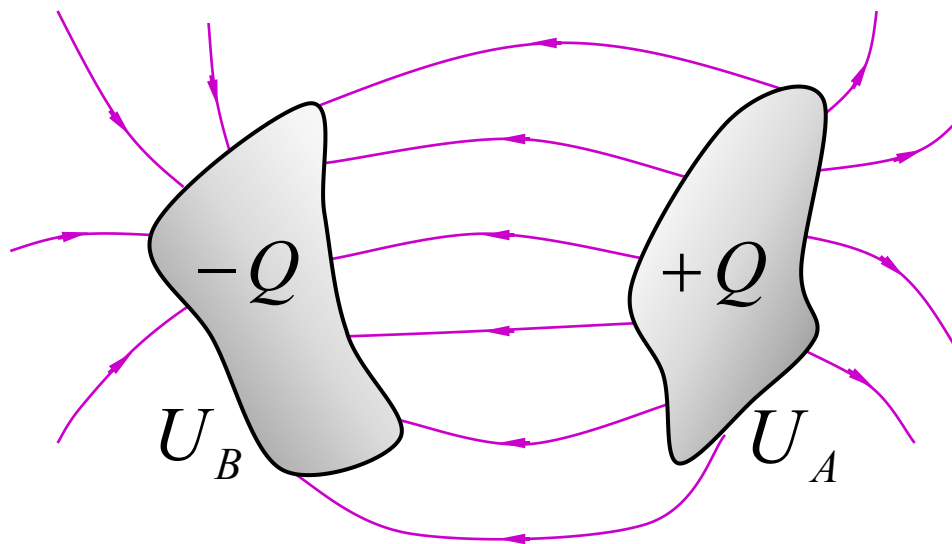
电容器由两个导体极板构成，串接在电路中，彼此带有等量异号的电荷。

以 $\text{—}||\text{—}$ 符号表示。

电容器的电容

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{Q}{\Delta U}$$

$$\Delta U = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



电容器电容的大小仅与导体的**形状**、**相对位置**、其间的**电介质**有关。与所带电荷量**无关**。

五、电容器电容的计算

1. 平板电容器

两带电平板间的电场强度

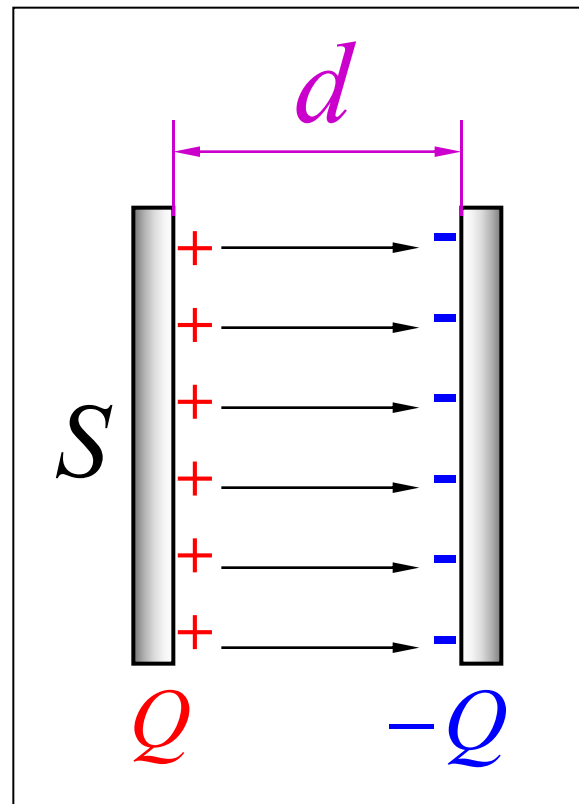
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

两带电平板间的电势差

$$\Delta U = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$$

平板电容器电容

$$C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$



2. 圆柱形电容器

设两导体圆柱面单位长度上分别带电 $\pm \lambda$

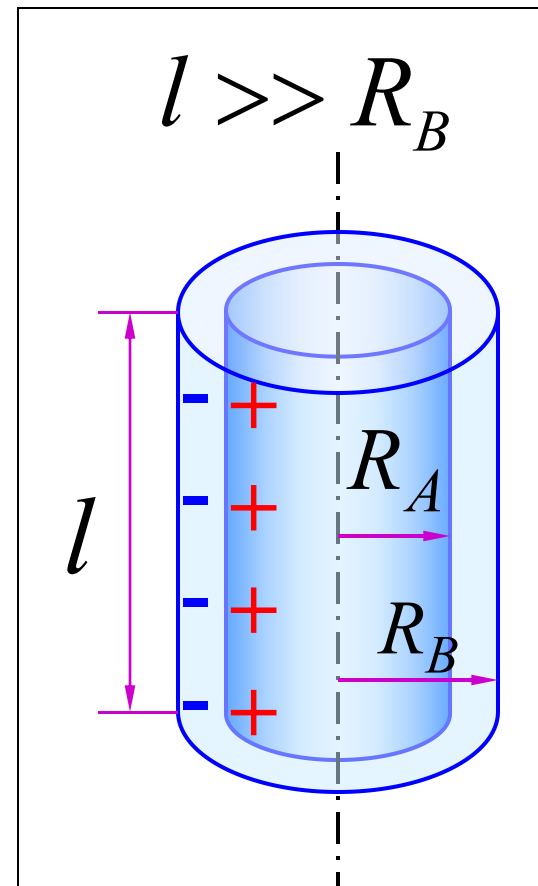
$$E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}, \quad (R_A < r < R_B)$$

$$\Delta U = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda dr}{2\pi \varepsilon_0 r} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 l} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta U} = (2\pi \varepsilon_0 l) / \ln \frac{R_B}{R_A}$$

若 $d = R_B - R_A \ll R_A$, 则 $\ln \frac{R_B}{R_A} = \ln \left(1 + \frac{d}{R_A} \right) \approx \frac{d}{R_A}$

故 $C \approx \frac{2\pi \varepsilon_0 l R_A}{d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$



3. 球形电容器的电容

球形电容器是由半径分别为 R_1 和 R_2 的两同心金属球壳所组成.

解 设内球带正电 ($+Q$)，外球带负电 ($-Q$) .

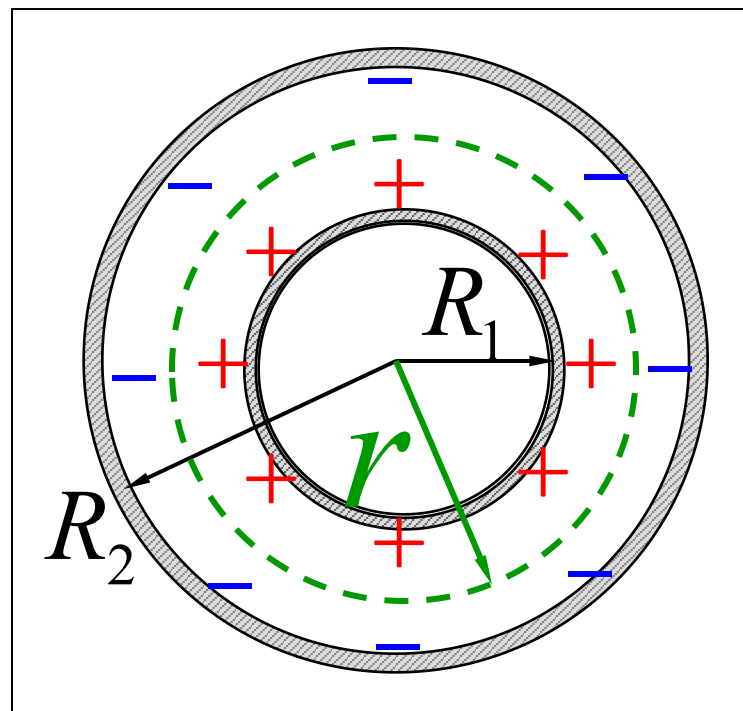
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\Delta U = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta U} = 4\pi \varepsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right)$$

$$R_2 \rightarrow \infty, \quad C = 4\pi \varepsilon_0 R_1$$



孤立导体球电容

电容器电容的计算

步骤

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{Q}{\Delta U}$$

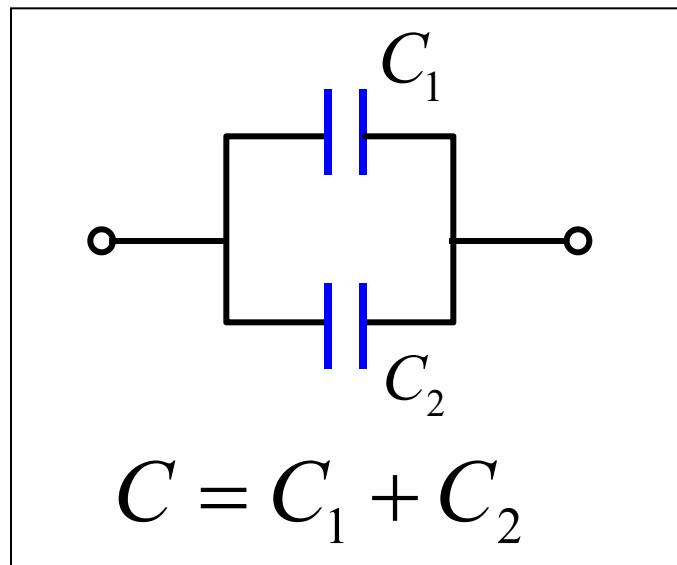
- (1) 设两极板分别带电 $\pm Q$
- (2) 求两极板间的电场强度 \vec{E}
- (3) 求两极板间的电势差 ΔU
- (4) 由 $C=Q/\Delta U$ 求 C

设 $Q \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow \Delta U \longrightarrow C = \frac{Q}{\Delta U}$

六、电容器的串联和并联

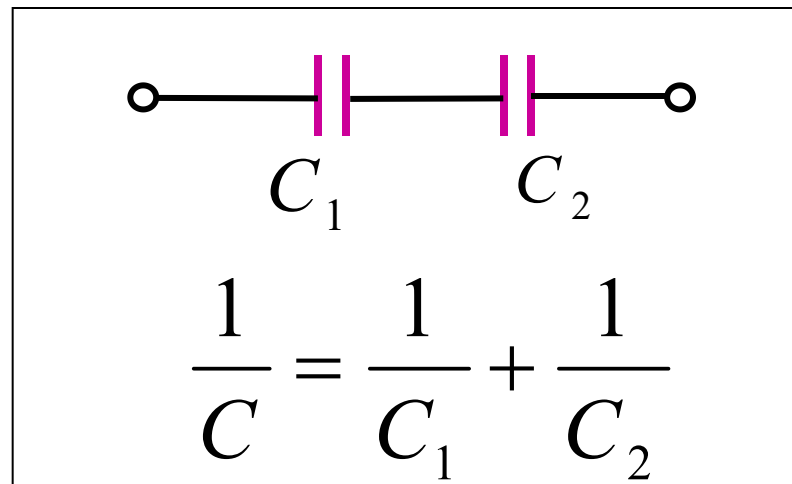
1. 电容器的并联

$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$



2. 电容器的串联

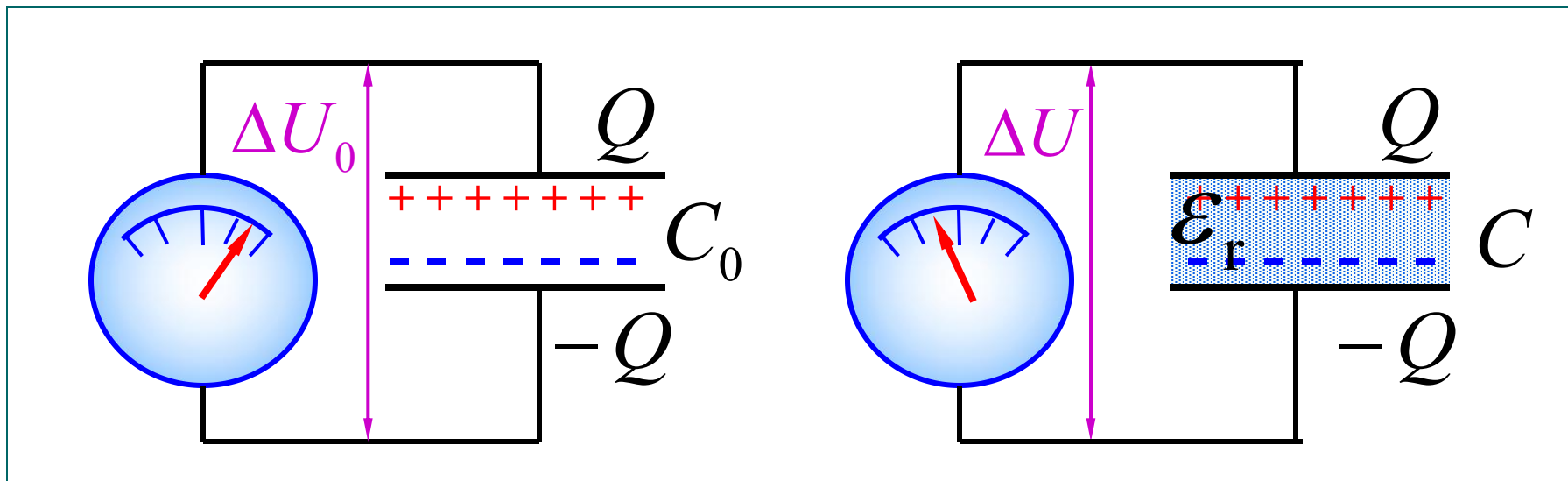
$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$



§ 7 电介质对电场的影响

电介质——绝缘体——“不导电”的物质

一、电介质对电容的影响



$$\Delta U = \frac{1}{\epsilon_r} \Delta U_0 \quad E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

$$C = \epsilon_r C_0$$

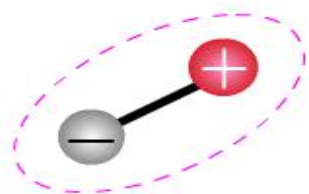
相对介电常数 $\epsilon_r \geq 1$

介电常数 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

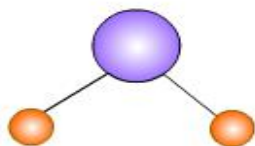
**电介质的极化

无极分子电介质：（氢、甲烷、石蜡等）

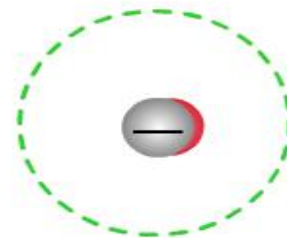
有极分子电介质：（水、有机玻璃等）



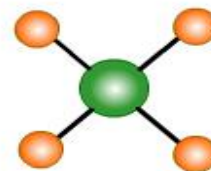
如 H_2O



有极分子



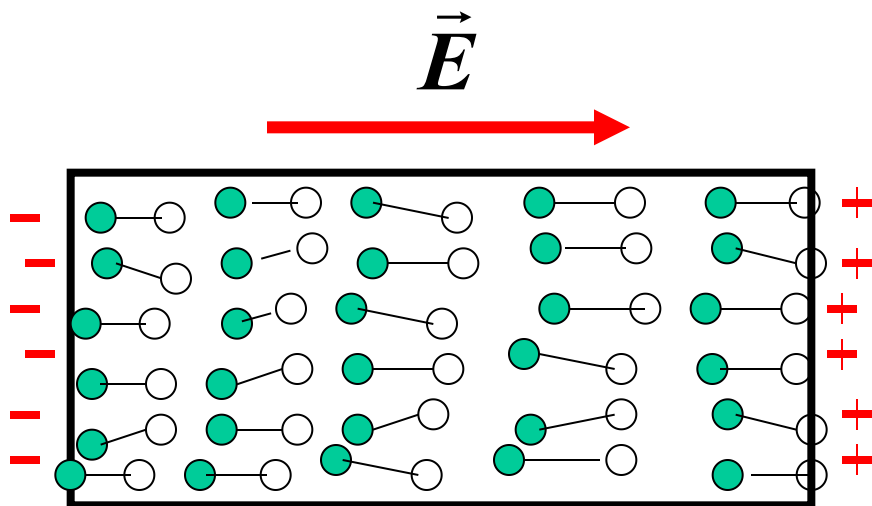
如 CH_4



无极分子

总之，不管哪种电介质，极化机制虽然不同，放到电场中都有极化现象，都会出现**极化电荷**（也叫**束缚电荷**）。

例如左图的左右表面上就有极化电荷。



正是这些极化电荷的电场削弱了电介质中的电场。

二、电介质中的电场强度

\vec{E}_0 —— 外电场的电场强度

\vec{E}' —— 极化电场的电场强度

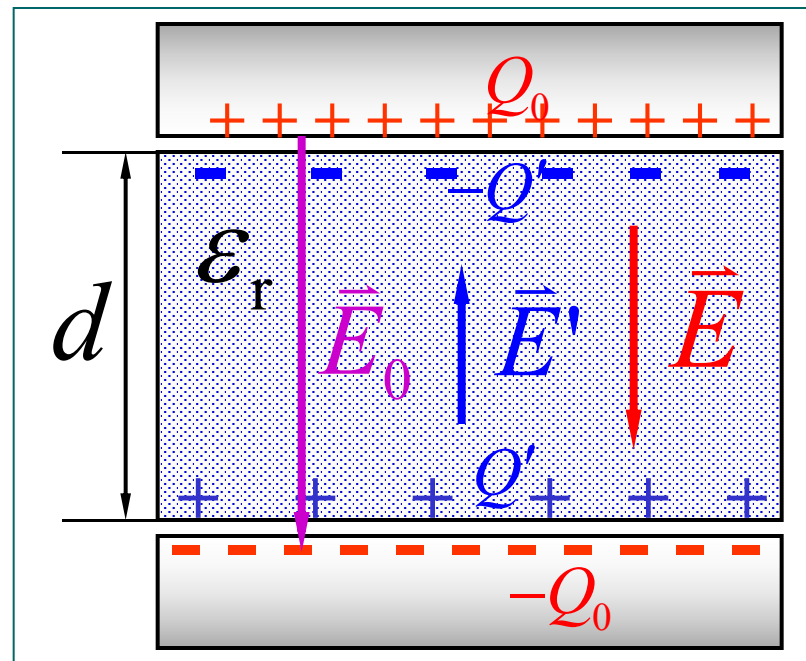
\vec{E} —— 总电场的电场强度

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$$

$$E' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} E_0$$

$$E_0 = \sigma_0 / \epsilon_0$$

$$E = E_0 / \epsilon_r = \sigma_0 / \epsilon_0 \epsilon_r$$



Q_0 : 导体上的自由电荷

Q' : 电介质中的极化电荷

$$Q' = -\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} Q_0$$

三、有介质时的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q_0 + q')$$
$$= \left(q_0 - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} q_0 \right) / \epsilon_0 = \frac{q_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\oint_S \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_0$$

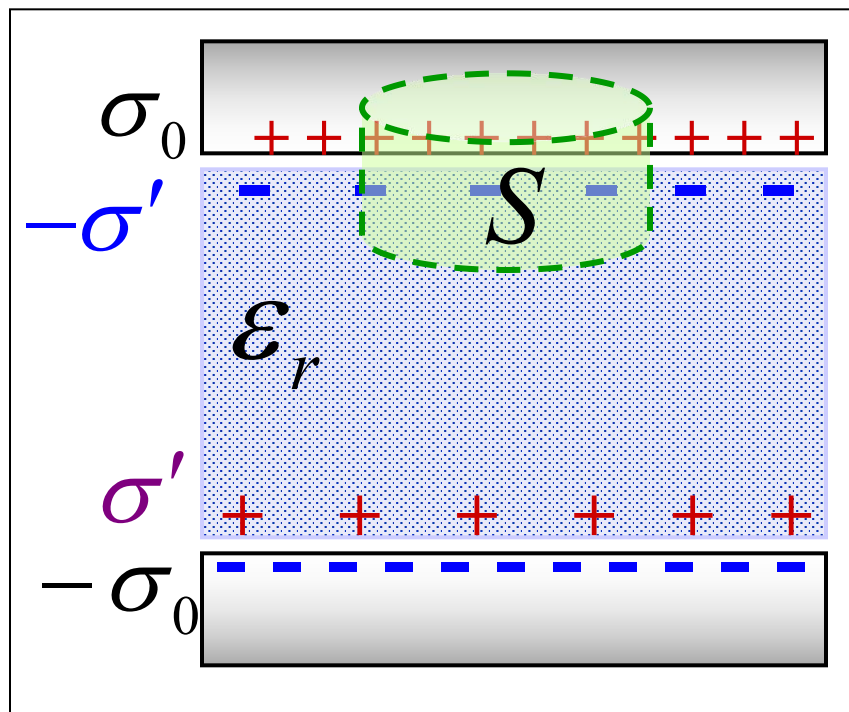
定义：电位移矢量

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

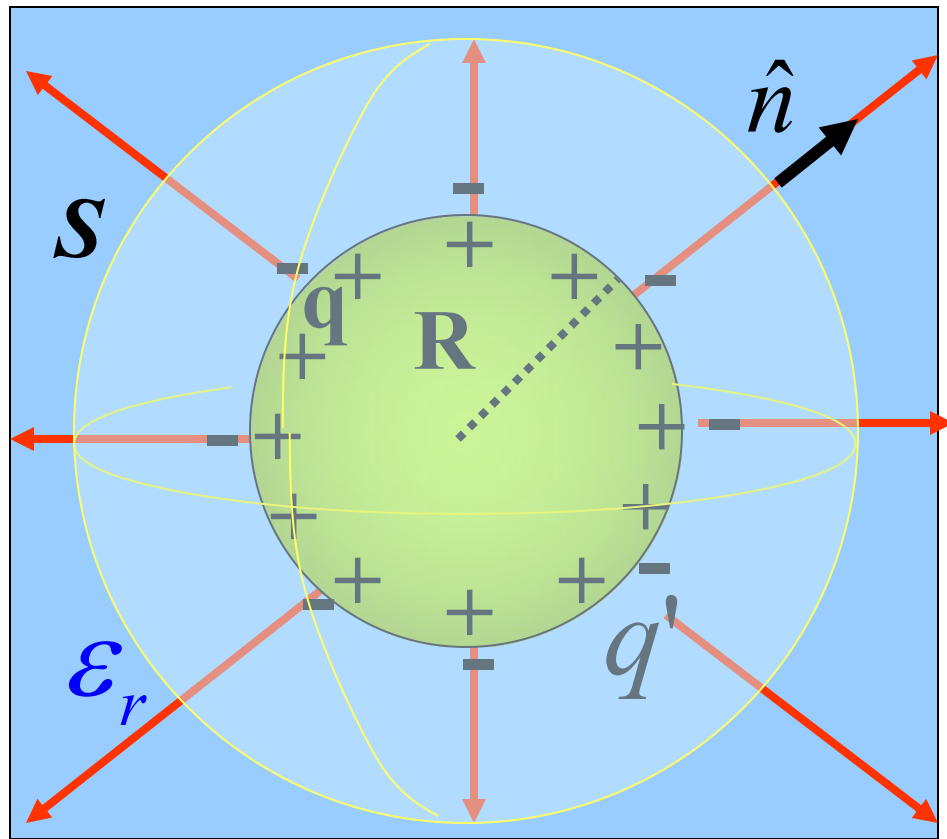
单位：C m⁻²

有介质时的高斯定理：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$



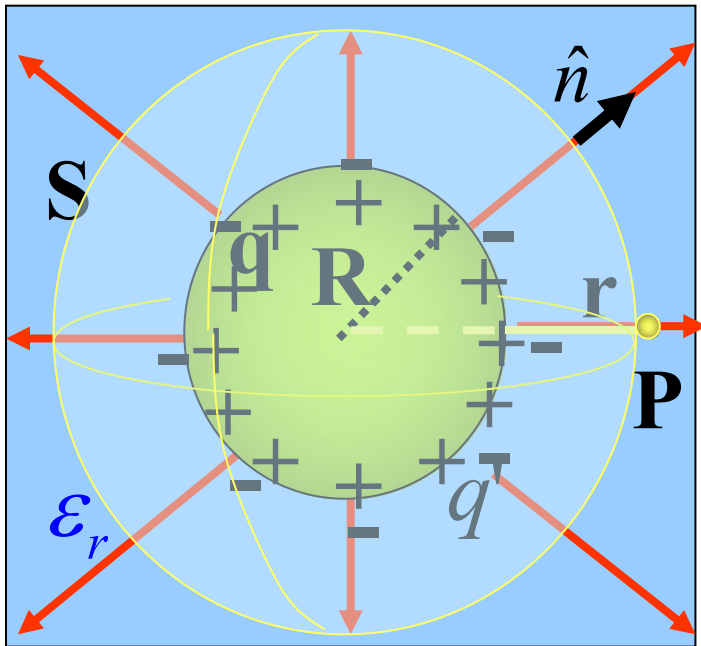
例：一导体带电球壳，带电 q ，周围充满无限大均匀介质，相对介电系数为 ϵ_r ，求球外一点 P 的场强、电势。



解：自由电荷与极化电荷都是球对称分布，故电场分布也是球对称分布。以半径 r 作高斯球面。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0 = q \quad D 4\pi r^2 = q$$

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r}$$



$$\because \vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{r}$$

$$U = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon r}$$

§ 8 静电场的能量

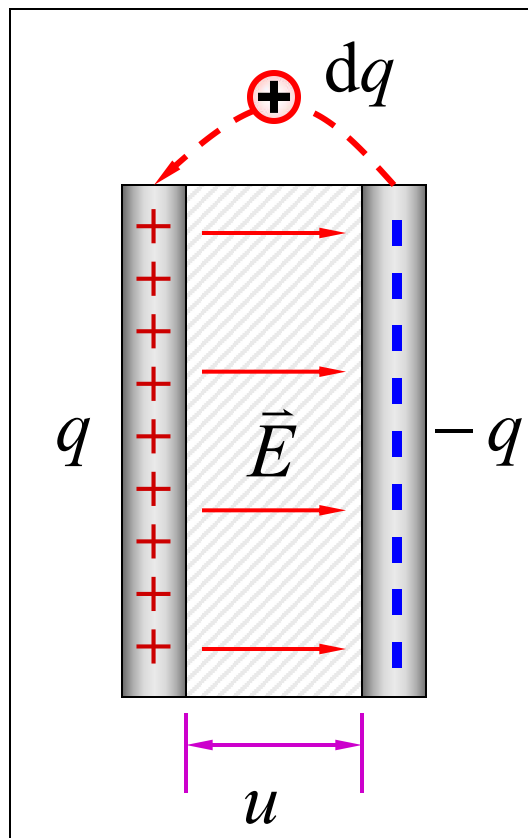
一、电容器的电能

$$dW = u dq = \frac{q}{C} dq$$

$$W = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C}$$

由 $C = \frac{Q}{U}$ 得：

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$



二、静电场的能量密度

1. 均匀电场——以平板电容器为例

$$W_e = \frac{1}{2} Q \Delta U = \frac{1}{2} C (\Delta U)^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd$$

能量密度: $w_e = \frac{W_e}{Sd} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$

电场空间所存储的能量: $W_e = w_e V$

2. 非均匀电场

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad dW_e = w_e dV = \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

$$W_e = \int_V dW_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

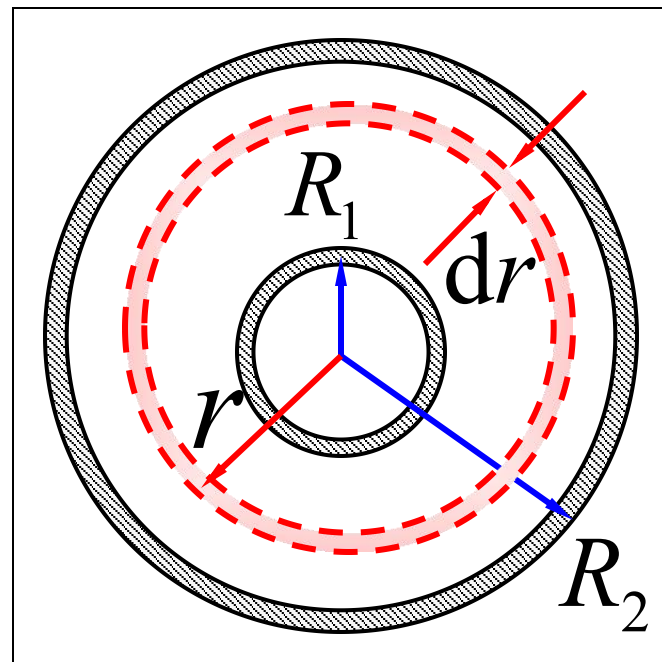
例1 如图所示,球形电容器的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 , 所带电荷为 $\pm Q$ 。若在两球壳间充以电容率为 ε 的电介质, 问此电容器贮存的电场能量为多少?

解:
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{Q}{r^2} \vec{r}_0 \quad (R_1 > r > R_2)$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon r^4}$$

$$dW_e = w_e dV = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon r^2} dr$$



$$\begin{aligned}
 W_e &= \int dW_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} \\
 &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}}
 \end{aligned}$$

讨论:

$$W_e = \frac{Q^2}{2C}$$

$$C = 4\pi\epsilon \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

——球形电容器电容

计算电容器中储存的电场能量，有以下两种方法：

$$\begin{array}{c} Q \\ \downarrow \\ E \end{array} \longrightarrow w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \longrightarrow W_e = \int_{V_{\text{体}}} w_e dV_{\text{体}}$$

$$\begin{array}{c} Q \\ \downarrow \\ \vec{E} \end{array} \longrightarrow \Delta U = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{l} \longrightarrow W_e = \frac{1}{2} Q \Delta U$$



Thank God it's Friday!